

а 2020 0053

Изобретение относится к технологии производства наноструктурированных материалов, в частности к способам получения наноструктур путем электрохимической обработки.

Способ, согласно изобретению, включает анодирование поверхности пластины GaAs с кристаллографической ориентацией (111)В в электролите. При этом, электролит содержит раствор 1М HNO₃, а анодирование проводится с приложением напряжения в диапазоне 3...4 V в течение 10...30 мин.

П. формулы: 1

Фиг.: 2